

【19】中華民國 **【12】發明公開公報 (A)**

【11】 公開編號：201921126

申請實體審查：有

【43】 公開日：中華民國 108 (2019) 年 06 月 01 日

【51】 Int. Cl. : *G03F7/20 (2006.01)*

【54】 發明名稱：用於量測在半導體基板上製造的特徵之參數的方法和設備

METHODS AND APPARATUS FOR MEASUREMENT OF A PARAMETER
OF A FEATURE FABRICATED ON A SEMICONDUCTOR SUBSTRATE

【21】 申請案號：107124567

【22】 申請日：中華民國 107 (2018) 年 07 月 17 日

【30】 優先權：2017/07/18

歐洲專利局

EP17181913

2018/01/26

歐洲專利局

EP18153569

【72】 發明人：帕薩瑞可 馬克辛 (MD) PISARENCO, MAXIM ; 凡 可拉吉 馬可斯 傑
拉度 馬堤司 瑪麗亞 (NL) VAN KRAAIJ, MARKUS GERARDUS
MARTINUS MARIA ; 高爾登 賽巴斯汀亞努斯 安德里亞努斯 (NL)
GOORDEN, SEBASTIANUS ADRIANUS

【71】 申請人：荷蘭商 A S M L 荷蘭公司
荷蘭

ASML NETHERLANDS B.V.

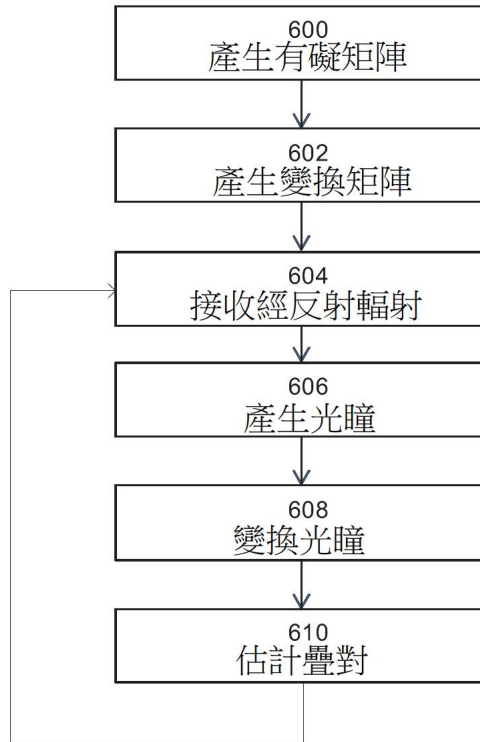
【74】 代理人：林嘉興

【57】 發明摘要：

本發明提供用於估計一基板上製造之一特徵之至少一個所關注參數的方法及設備，該特徵包含複數個結構參數，該等結構參數包含該至少一個所關注參數及一或多個有礙參數。一接收器接收自該基板上之一或多個經量測特徵散射之輻射；一光瞳產生器產生該接收到的輻射之一未經處理光瞳表示；一矩陣乘法器使變換矩陣乘以該未經處理光瞳表示之像素中之每一者之強度以判定該等有礙參數之影響經緩解或移除之一經後處理光瞳表示；以及一參數估計器基於該經後處理光瞳表示估計該至少一個所關注參數。

指定代表圖：

(2)



【圖6】

符號簡單說明：

600 . . . 產生有礙矩陣

602 . . . 產生變換矩陣

604 . . . 接收經反射輻射

606 . . . 產生光瞳

608 . . . 變換光瞳

610 . . . 估計疊對